

Є. Ф. Венгер

Калабухова Катерина Миколаївна



КАЛАБУХОВА Катерина Миколаївна (20. 11. 1947, Тбілісі) – фізик. Дочка [М. Калабухова](#). Доктор фізико-математичних наук (2005). Закін. Київ. політех. інститут (1971). Від 1975 працює в Інституті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 2006 – провідний науковий співробітник. Досліджує монокристал., аморфні та нанорозмірні напівпровідник. матеріали за допомогою методів високорозділ. та імпульс. радіоспектроскопії; розробляє імпульсне мікрохвильове обладнання для спектрометрів магніт. резонансу.

Основні праці

Intrinsic defects in SiC nanoparticles as studied by pulsed electron paramagnetic resonance // Solid State Communications. 2008. Vol. 146, № 1–2; Кинетика поведения фоточувствительных примесей и дефектов в особо чистом полуизолирующем карбиде кремния // ФТТ. 2009. Т. 51, № 4; Spin-coupling and hyperfine interaction of the nitrogen donors in 6H-SiC // Physica Status Solidi B. 2009. Vol. 246, № 8; The EPR study of the carbon and silicon related defects in carbon-rich hydrogenated amorphous silicon-carbon films // Phys. Rev. B. 2010. Vol. 88, № 15 (усі – співавт.).

Бібліографічний опис:

Калабухова Катерина Миколаївна / Є. Ф. Венгер // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-10351>

2001-2025 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України ([докладніше](#)).